

	<h2 style="color: #E67E22;">SI7403BDN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI7403BDN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 8A 1212-8 PPAK
	Datenblätter:  SI7403BDN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 31524 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





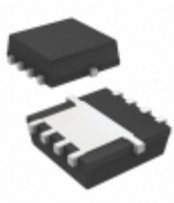


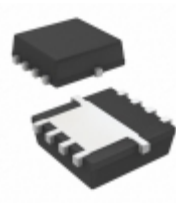
Spezifikationen

Teilenummer	SI7403BDN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 8A 1212-8 PPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	31524 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	74 mOhm @ 5.1A, 4.5V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 9.6W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SI7403BDN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	430pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 8A (Tc) 3.1W (Ta), 9.6W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

SI7403BDN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7403BDN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7403BDN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7403BDN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7403BDN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 8A 1212-8</p>	 <p>SI7404DN VISHAY SI7404DN VISHAY</p>	 <p>SI7403DN SI SI7403DN SI</p>	 <p>SI7403DN-T1-E3 VISHAY SI7403DN-T1-E3 VISHAY</p>
 <p>SI7402DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 13A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7403BDN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 8A 1212-8</p>	 <p>SI7403BDN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 8A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SI7402DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 13A PPAK 1212-8</p>

SI7403BDN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI7403BDN-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7403BDN-T1-GE3 Datenblatt	SI7403BDN-T1-GE3-Datenblätter	SI7403BDN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI7403BDN-T1-GE3 Electronic	SI7403BDN-T1-GE3	SI7403BDN-T1-GE3-Komponenten	SI7403BDN-T1-GE3-Verteiler	SI7403BDN-T1-GE3-Bild	SI7403BDN-T1-GE3
SI7403BDN-T1-GE3 Preis	SI7403BDN-T1-GE3	SI7403BDN-T1-GE3 Hersteller	SI7403BDN-T1-GE3 Bild	SI7403BDN-T1-GE3 Aktie	SI7403BDN-T1-GE3-Teil
SI7403BDN-T1-GE3 Neu	SI7403BDN-T1-GE3	SI7403BDN-T1-GE3 Original	SI7403BDN-T1-GE3 garantiert	SI7403BDN-T1-GE3 RFQ	SI7403BDN-T1-GE3 Inventar
					SI7403BDN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited